

A New Field-Effect Transistor with Selectively Doped $GaAs/n - Al_xGa_{1-x}As$ Heterojunction

Discussie & kwalitatieve analyse

Halfgeleiders
Jelle Verstraaten, 500236946
`jelle@benext.nl`
Erik Steuten
E-technology
29 mei 2015

Inhoudsopgave

Bibliografie